کاهش ظرفیت خازن لینک DC در اینور ترهای خورشیدی متصل به شبکه با استفاده از یک مدار متعادل کننده موازی

مرتضی حیدری'، دانشجوی دکتری؛ محمدعلی شمسینژاد'، دانشیار؛ محمد منفرد'، دانشیار

morteza.heidari@birjand.ac.ir – دانشگاه بیرجند – بیرجند – ایران – mshamsi@birjand.ac.ir – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه بیرجند – بیرجند – ایران – mshamsi@birjand.ac.ir ۳- دانشکده مهندسی – دانشگاه فردوسی – مشهد – ایران – m.monfared@um.ac.ir

چکیده: امروزه اینورترهای تکفاز متصلبه شبکه بهصورت گستردهای در کاربردهای توان پایین، مراکز صنعتی و مسکونی بهعنوان تأمین کننده توان مورداستفاده قرار گرفتهاند. در سیستمهای تکفاز توان ریپلی ذاتی با فرکانسی دو برابر فرکانس شبکه باعث بهوجودآمدن نوسانات فرکانس پایین نامطلوب در ولتاژ لینک DC و جریان خروجی میشود. البته این مسئله با نصب یا استفاده از یک خازن الکترولیتی بزرگ برطرف میشود. اما استفاده از این فیلتر پسیو به این بزرگی منجربه کاهش اجتنابناپذیر طول عمر و قابلیت اطمینان سیستم میشود. برای غلبه بر این مشکلات از روشهای کمکی متعادل سازی توان برای کاهش ظرفیت خازن و جای گزینی آن با خازنهای فیلمی، استفاده میشود. در این مقاله با معرفی یک جبران گر موازی و بهره گیری از تئوری توانهای لحظهای ظرفیت خازن متعادل کننده توان کاهش چشم گیری داشتهاست. ساختار سیستم کنترلی پیشنهادی براساس تئوریpq اصلاحشده و مدل سازی سیستم تکفاز به صورت یک سیستم سهفاز نامتعادل است. شبیه سازی سیستم براساس سیستم ۳ کیلووات نصب شده در دانشگاه بیرجند است. عمل کرد سیستم پیشنهادی به سازی متعادل است. شبیه سازی سیستم براساس سیستم می فرو می برای مقایسه هزولتاییک ۳ کیلووات نصب شده در دانشگاه بیرجند است. عمل کرد سیستم پیشنهادی به نتایج شبیه سازی تأیید شده است و در پایان مقایسه هزینه ای بین ساختار پیشنهادی با ساختار متداول نیز انجام شده است.

واژههای کلیدی: اینورتر متصل به شبکه، تئوری توانهای لحظهای بهبودیافته، جبران گر موازی، خازن لینک DC، هزینه.

Reducing the Dc-Link Capacitance for Grid-Connected Solar Inverters with Shunt Power Decoupling Circuit

M. Heidari¹, Phd student; M. A. Shamsi-Nejad², Associate Professor; M. Monfared³, Associate Professor³

1- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran, Email: morteza.heidari@birjand.ac.ir
 2- Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran, Email: mshamsi@birjand.ac.ir
 3- Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, Email: m.monfared@um.ac.ir

Abstract: Single phase grid-tied inverters are remarkably increasing in low-power applications such as residential and industrial power supplies. In the single phase system, the inherent ripple power at twice the line frequency results in undesirable low-frequency ripple in the dc-link voltage and output ac current. This issue can be eased through the installation of bulky electrolytic capacitors in the dc link. However, such passive filtering approach may inevitably lead to limited system lifetime and reliability. To overcome these problems, auxiliary power decoupling methods are used to reduce the size of the electrolytic capacitor and replace it with film capacitor. In this paper, By introducing a shunt switching compensator (SSC) and exploiting instantaneous power theory (pq theory), the size of the required capacitance remarkably decreased. The proposed controlling system, based on the modified pq theory and single-phase modeling, was similar to a three-phase unbalanced system regarding the structure. The system simulation was according to the 3Kw photovoltaic system used at the Birjand University. The simulation results verify the proposed power decoupling technique. At the end, a cost comparison between the proposed structure and prevalent structure is also done.

Keywords: Cost, DC link capacitor Grid-tied inverter, Modified instantaneous power theory, Shunt switching compensator.

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ تاریخ اصلاح مقاله: ۱۳۹۷/۰۳/۲۴، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ و ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ نام نویسنده مسئول: محمدعلی شمسینژاد نشانی نویسنده مسئول: ایران – تبریز – بلوار ۲۹ بهمن – دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر.

۱– مقدمه

پیشرفتهای فنّاورانه و مشکلات ناشی از احداث و نگهداری نیروگاههای بزرگ و تلفات زیاد شبکههای سراسری انتقال و توزیع، باعث ورود روزافزون تولیدات پراکنده در سیستمهای قدرت شدهاست و این مولدها را به استراتژی جدید شرکتهای برق در تأمین انرژی الکتریکی تبدیل کردهاست. ازطرفی با افزایش تقاضا برای انرژی در جهان و همچنین روبهاتمامبودن منابع فسیلی موجود، نیاز به تعریف منابع جدید انرژی بهمنظور پوشش نیازهای انرژی آینده امری ضروری است. به همین منظور در سالهای گذشته، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر، بهخصوص انرژی بادی و خورشیدی برای تزریق توان به سیستم قدرت روند روبهرشدی داشتهاست.

در ۲۰ سال گذشته، انرژی الکتریکی خورشیدی با رشدی حدود ۳۰ درصدی مواجه شدهاست. بهطوری که نصب سیستمهای فتوولتاییک در سال ۲۰۱۵ در جهان به رکوردی به مقدار بیش از ۵۰/۹ گیگاوات رسیدهاست که رشدی حدود ۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد [۱]. در این میان سیستمهای متصل به شبکه بیش ترین سهم را در بازار داشتهاند [۲]. یکی از مهم ترین اجزای ماژولهای سلول خورشیدی برای اتصال به شبکه قدرت، اینور ترهای متصل به شبکه می باشند. در این میان اتصال منابع انرژی خورشیدی به شبکه از طریق اینور ترهای تکفاز باتوجه به مزایا و سهولت نصب آنها برای مصرف کنندههای محلی و عاری بودن از هر نوع آلودگی به صورت قابل ملاحظهای در حال افزایش است [۳].

در اتصال تکفاز، شارش توان به سمت شبکه متغیر با زمان است درحالی که توان استخراجشده از سلول فتوولتاییک برای حصول به بیشینه انرژی خروجی، باید ثابت باشد. درنتیجه یک عدم تناسب بین توان لحظهای ورودی و توان لحظهای ac خروجی به وجود میآید. برای ازبینبردن اثر این نامتعادلی توان باید از عناصر ذخیره کننده انرژی بین ورودی و خروجی استفاده شود. باتوجهبه ظرفیت موردنیاز برای عنصر ذخیرهکننده انرژی، معمولاً از یک خازن الکترولیتی برای ایفای نقش متعادل كننده توان استفاده مى شود. خازن هاى الكتروليتى طول عمر بسیار محدودی در حدود ۱۰۰۰-۷۰۰۰ ساعت دارند و طول عمر این خازنها وابستگی شدیدی به دمای محیط دارند و با افزایش دما، طول عمرشان بهطور قابل توجهی کاهش می یابد [۴]. همچنین آمارها نشان میدهد ۳۰ درصد از خرابیهای سیستمهای الکتریکی به علت اختلال در عمل کرد خازنها به وجود میآید [۴]. بیشتر اینورترهای امروزی باوجود محدودبودن طول عمر خازنهای الکترولیتی از این خازنها بهعنوان عنصر ذخیره کننده در برقراری تعادل توان استفاده می کنند و این به علت ظرفیت بالای این خازنها و پیادهسازی آسان در اينورترهاست [۴-8]. بنابراين يک عدم تناسب بين طول عمر خازن الكتروليتي و ساير تجهيزات اينورتر كه براي طول عمر بيشتر طراحي شدهاند، به وجود خواهدآمد. همچنین قابلیت اطمینان خازنهای الکترولیتی بهمراتب کمتر از سایر خازنها است و برای سیستمهای

انتقال توان با راندمان بالا، تعویض خازنها و اندازه گیری پارامترهای آنها بهصورت دورهای امری ضروری است که این منجربه افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری و افزایش زبالههای الکترونیکی میشود. تحقیقات بسیاری در جهت کاهش سایز خازن متعادل کننده توان انجام گرفته و در حال انجام است تا بهجای استفاده از خازنهای الکترولیتی با ظرفیت بزرگ و طول عمر پایین بتوان از خازنهای فیلمی (پلی پروپیلن) که طول انجام شده در رنج توانهای پایین و مربوط به میکرو اینورترهاست راتوانهای زیر ۵۰۰ وات) و باتوجهبه این که ظرفیت خازن متعادل کننده توان ارتباط مستقیمی با توان خروجی دارد و افزایش توان خروجی منجربه افزایش ظرفیت خازن متعادل کننده توان میشود تعداد مقالات کمی به رنج توانی بالا پرداختهاند. باتوجهبه توپولوژی اینورترها و مکان متعادل سازی ارائه شدهاست [۲۰–۲۷].

در روش پیشنهادی مرجع [۷] برای یک اینورتر ۱۱۰ واتی با استفاده از تکنیک فیلتر اکتیو، ظرفیت خازن متعادل کننده از ۲۶۰۰ میکروفاراد به ۵۰ میکروفاراد کاهش یافتهاست. بهعلت وجود یکسوکننده دیودی، جریان شبکه برابر است با مجموع جریان اینورتر و جریان مدار تخلیه که شامل هارمونیک است و این اعوجاج در جریان شبکه، باعث هدررفت انرژی شده و راندمان را کاهش میدهد. در مرجع [۸] یک اینورتر یکمرحلهای فلایبک و یک مدار کمکی متعادل کننده توان را معرفی کرده است. با استفاده از توپولوژی پیشنهادی در این مرجع برای یک سیستم ۱۰۰ واتی ظرفیت خازن متعادل کننده به ۴۰ میکرو فاراد کاهش یافتهاست. بهعلت پروسه آبشاری، بازده عمل کردی سیستم پایین و در حدود ۷۰ درصد است. مرجع [۹] یک اینورتر تکمرحلهای فلایبک بهبودیافته را پیشنهاد میکند که در آن انرژی اندوکتانس نشتی با استفاده از یک مبدل فلایبک دوکلیدی، بازیابی شدهاست. باتوجهبه آنچه در مرجع ذکرشده، از این روش می توان به بازدهی حداکثر ۸۶/۷ درصد دستیافت. در مراجع [۱۰] و [۱۱] توپولوژی فلای بک با سه در گاه پیشنهاد شدهاست که یک درگاه فقط عمل متعادلسازی توان را انجام میدهد. در این ساختار، خازن متعادل کننده، هم بهعنوان عنصر ذخیره کننده انرژی و هم به عنوان اسنابر برای بازیابی انرژی نشتی در این مدار نقش ایفا میکند. برای یک اینورتر ۱۰۰ واتی، خازن متعادل کننده می تواند مقادیری نسبتاً کوچکی در حدود ۴۶ میکرو فاراد در ولتاژ ۱۵۰ ولت داشتهباشد. با ساختارهای پیشنهادی بازدهی در حدود ۹۰/۶ درصد تخمین زده شدهاست.در مرجع [۱۲] برای کاهش ظرفیت خازن متعادل کننده توان یک میکرو اینورتر ۵۰۰ واتی، از یک مبدل - Push Pull و یک مدار متعادلکننده استفاده شدهاست که خازن متعادل کنندهای به کوچکی ۵۰ میکرو فاراد را دارد. پیچیدگی توپولوژی اينورتر يا كاهش راندمان كل سيستم از مشكلات اين روش است.نویسندگان در مرجع [۱۳] با ترکیب مبدل بوست و مبدل فلای

بک توانستهاند با خازن کوچکتری عمل متعادلسازی توان را انجام دهند.

در مرجع [۱۴، ۱۵] تکنیک متعادلسازی توان در سمت شبکه پیشنهاد شدهاست. یکپایه اضافی در سمت ac برای تطبیقدادن خازن متعادلکننده بین اینورتر و شبکه در مدار اضافه شدهاست. عمل کرد مدار پیشنهادی به گونهای است که توان لحظهای گذرنده از سمت لینک DC به سمت شبکه با کلید زنی ثابت نگه داشته می شود.

با قراردادن خازن در لینک dc در اینورترهای دومرحلهای، ریپل ولتاژ افزایش می یابد و می توان ظرفیت خازن متعادل کننده را کاهش داد اما این افزایش ریپل ولتاژ ممکن است باعث خراب شدن و اعوجاجی کردن شکل موج جریان خروجی شود. در مرجع [۱۶] با استفاده از یک روش كنترلى و بهبود روش مدولاسيون تأثيرات ريپل ولتاژ را مىتوان كاهش داد. در مرجع [۱۷] با استفاده از یک منبع ولتاژ سری با خازن متعادل کننده، ریپل ولتاژ خازن لینک dc جبران می شود و ظرفیت خازن متعادل كننده كاهش پيدا مى كند. از آنجاكه جبران كننده ولتاژ، ريپل ولتاژ کوچکی را با توان راکتیو جبران میکند، می توان با تجهیزات ولتاژ پایین آن را پیادهسازی نمود. در مرجع [۱۸] از یک خازن متعادل کننده توان سری استفاده شدهاست. این ساختار از چهار قسمت اصلی اینورتر، ترانسفورماتور، بافر و سیکلوکانورتر تشکیل شدهاست که بهصورت سری به هم متصل شدهاند. در مراجع [۲۰-۱۹] یک مبدل فلایبک چهارکلیده بههمراه یک مدار متعادلکننده سری پیشنهاد شدهاست. در پایان اگر بین روشهای مختلف متعادلسازی توان ازنظر اندازه خازن متعادل کننده و بازده کل سیستم مقایسهای انجام شود، می توان گفت در مواردی که در آنها مدار متعادل کننده در سمت سلول فتوولتاییک قرار دارد، ازنظر بازدهی قراردادن خازن موردنظر در پایانههای سلول خورشيدى بهصورت مستقيم، مىتواند انتخابى بهينه باشد. بااينوجود نیاز به ظرفیت خازن بزرگتری است که هزینهها را افزایش و درنهایت طول عمر تجهیز را کاهش میدهد. برای مواردی که خازن متعادل کننده در لینک DC قرار دارد، دارای استراتژی کنترلی سادهتری است. بااینوجود این روشها فقط برای اینورترهایی با آرایش چندمرحلهای که در آنها لینک DC قابل پیادهسازی است، قابل اجرا است. در مواردی که خازن متعادل کننده در سمت AC قرار دارد، اندازه ظرفیت خازنی بهدلیل نوسان ولتاژ بالا، بسیار کوچک خواهدبود. اما یکپایه فاز اضافی به مدار افزودهشده که هزینهها را افزایش میدهد و بیشتر برای توپولوژیهای منبع جریانی کاربرد دارد. همچنین این ساختار نیازمند کلیدهای دوطرفه است که بر پیچیدگی کنترلی میافزاید.

در این مقاله از یک اینورتر سه کیلوواتی دومرحلهای استفاده شدهاست و یک جبران گر توان بهصورت موازی برای کاهش سایز خازن ذخیره کننده انرژی پیشنهاد شدهاست. اساس کار این جبران گر بدین گونه است که توان متغیر با زمان مورد نیاز سمت شبکه را تأمین کند. درنتیجه می توان به جای استفاده از یک خازن الکترولیتی بزرگ که وظیفه کنترل این توان پالسی را بر عهده دارد، از یک خازن با ظرفیت کوچک تر و ترجیحاً از نوع فیلمی با طول عمر بیش تر استفاده نمود. با

اتصال جبران گر، ریپل ولتاژ لینک DC افزایش یافته و ظرفیت خازن متعادل کننده توان در لینک DC کاهش مییابد. برای کنترل توان خروجی این جبران گر موازی از روش pq اصلاح شده استفاده شده است و سیستم تکفاز به صورت یک سیستم سهفاز نامتعادل مدل گردیده است. در روش کنترلی پیشنهادی دیگر نیاز به تولید فاز مجازی β برای جریان نمی باشد. در نتیجه از پیچیدگی مسئله کاسته شده است. سیستم کنترلی پیشنهادی توانسته است علی رغم افزایش ریپل ولتاژ لینک DC، اعوجاج جریان تزریقی به شبکه را کاهش داده و مقدار THD جریان را به حد مطلوب استانداردها و الزامات اتصال به شبکه برساند. ساختار مقاله انرژی بیان شده است. ساختار و سیستم کنترلی پیشنهادی در قسمت ۳ معرفی شده است. در قسمت ۴ گامهای طراحی فیلتر خروجیLCL برای اتصال اینور تر به شبکه تک فاز بیان شده و در پایان نتایج شبیه سازی و مقایسه هزینه ای بین ساختار پیشنهادی و ساختار متداوی و

۲- لزوم استفاده از عناصر ذخیره کننده انرژی

شکل زیر پیکربندی اینورتر تکفاز دومرحلهای متصلبهشبکه را نشان میدهد. این پیکربندی از یک مبدل DC به DC و یک پل H تکفاز تشکیل شدهاست. مبدل DC به DC وظیفه دستیابی به نقطه حداکثر توان را بر عهده دارد.



شکل ۱: پیکربندی اینورتر تکفاز دومرحلهای متصل به شبکه

تزریق توان به شبکه در سیستم تکفاز با درنظر گرفتن ولتاژ و جریان سینوسی بهصورت زیر است:

$$P_{grid}(t) = V_{grid}(t)I_{grid}(t) \tag{1}$$
$$\left\{ V_{grid}(t) = V_m \cos(\omega t) \tag{2} \right\}$$

$$\begin{cases} I_{grid}(t) = I_m \cos(\omega t - \varphi) \end{cases}$$

که در آن Vm و Im بهترتیب دامنه ولتاژ شبکه و جریان تزریقی به شبکه، ۵ فرکانس زاویهای شبکه و

 اختلاففاز بین ولتاژ و جریان شبکه است.

 با جایگذاری رابطه ۲ در ۱ خواهیمداشت:

$$\begin{split} P_{grid}(t) &= \frac{1}{r} V_m I_m \cos(\varphi) + \frac{1}{r} V_m I_m \cos(\tau \omega t - \varphi) \end{split} \tag{7}$$

$$P_{grid}(t) &= V_m I_m \cos(\varphi) + \frac{1}{r} V_m I_m \cos(\tau \omega t - \varphi)$$

$$P_{grid}(t) &= V_{PV} + P_{PV} \cos(\tau \omega t) \end{aligned} \tag{7}$$

همان طور که در رابطه ۴ مشاهده می شود توان لحظهای تزریقی به شبکه از دو قسمت تشکیل شدهاست. یک قسمت توان متوسط خروجی که با درنظر گرفتن حالت بدون تلفات همان توان تولیدی سلول خروجی $d\tilde{v}(t)$

(Ppv)است و قسمت دیگر یک توان متغیر بازمان که با فرکانسی دو برابر فرکانس شبکه نوسان (توان پالسی) میکند.

باتوجه بهاینکه عمل کرد سیستم دستیابی به نقطه کار بیشینه توان ('MPPT) به گونهای است که توان خروجی از سلول خورشیدی همیشه یک مقدار ثابت باشد، بنابراین برای برقراری تعادل توان بایستی توان پالسی (P_{grid}-P_{PV}) ب توسط یک عنصر ذخیره کننده انرژی (خازن متعادل کننده توان) کنترل گردد. نحوه عمل کرد خازن متعادل کننده به صورت شکل ۲ است.



شکل ۲: نحوه عمل کرد خازن متعادل کننده

همان طور که در شکل ۲ مشاهده می شود خازن متعادل کننده توان دارای دو حالت کاری است. زمانی که توان شبکه از توان تولیدی سلول فتوولتاییک کمتر باشد، این تفاوت انرژی با تخلیه انرژی خازن متعادل کننده جبران می شود. زمانی که توان سلول فتوولتاییک از توان شبکه بیش تر باشد، این مازاد انرژی در خازن متعادل کننده ذخیره می شود. باتوجهبه عمل کرد این خازن در متعادل سازی توان ورودی و خروجی، طراحی و قراردادن مقدار صحیح برای خازن متعادل کننده در جهت عمل کرد مطلوب سیستم، امری ضروری است. انتخاب مقدار کوچک برای این خازن باعث یک عدم تعادل بین توان خروجی و توان ورودی سیستم شده و نتایجی چون افزایش مقدار تغییرات ولتاژ دو سر خازن، ایجاد اشکال در عمل کرد سیستم MPPT (وجود ریپل در پایانه خازن، ایجاد اشکال در عمل کرد سیستم توان استخراج شده از سلول خورشیدی) و افزایش اعوجاج در جریان تزریقی به شبکه را در پی خواهدداشت [۲۱].

با توجه به اینکه توان پالسی باید توسط خازن کنترل شود، میتوان توان لحظهای خازن را بهصورت زیر نوشت [۲۲]:

$$P_{c}(t) = v_{c}(t) \cdot i_{c}(t) = P_{grid}(t) - P_{PV}(t) \qquad (\Delta)$$
$$= P \cos(\tau \omega t) = V_{dc} \cdot I_{dc} \cos(\tau \omega t)$$

که در آن J_{dc} و U_{dc} بهترتیب دامنه جریان خازن و ولتاژ لینک DC است. طبق رابطه ۵ با ثابت درنظر گرفتن ولتاژ خازن، جریان خازن هماهنگ با توان نوسان میکند. درنتیجه جریان لحظهای خازن بهصورت زیر است: $i_c(t) = I_{dc} \cos(\tau \omega t) = \frac{P}{V_{dc}} \cos(\tau \omega t)$

همچنین یک رابطه دیگر هم برای محاسبه جریان خازن وجود دارد:

$$i_{c}(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$$
(Y)
$$i_{c}(t) = V \frac{1}{dt}$$

$$v_{c}(t) = V \frac{1}{dc} + \tilde{v}(t) = V \frac{1}{c} \int i_{c}(t) dt$$
(A)
$$i_{c}(t) = V \frac{1}{c} \int i_{c}(t) dt$$

$$i_{c}(t) = V \frac{1}{c} \int i_{c}(t) dt$$
(A)

$$v_{c}(t) = V_{dc} + \frac{1}{c} \int I_{dc} \cos(\tau \omega t) dt$$
(9)

درنتیجه میتوان گفت ولتاژ لینک DC دارای ریپلی با دو برابر فرکانس شبکه بهصورت زیر است: (۱۰) $\tilde{v}(t) = V_r \sin(\tau \omega t)$ با جایگذاری رابطه فوق در رابطه در رابطه ۲ خواهیمداشت: i (t) = τωCV cos(τωt) (۱۱)

با استفاده از دو رابطه ۱۱ و رابطه ۶ مقدار خازن لینک DC با توجه
با مقدار در نظر گرفتهشده برای ریپل ولتاژ لینک DC به دست می آید.
(۱۲)
$$C = \frac{P}{\tau \pi f V_{dc} \Delta V}$$

که در آن f فرکانس شبکه وΔ۷ مقدار مجاز ریپل پیکتاپیک ولتاژ لینک DC است. به طور مثال برای یک اینور تر ۳ کیلوواتی با ولتاژ لینک DC است. به طور مثال برای یک اینور تر ۳ کیلوواتی با ولتاژ لینک DC و درصد ریپل مجاز ۲/۵٪ مقدار خازن متعادل کننده ۴ میکروفاراد الکترولیتی استفاده نمود. همان طور که در رابطه فوق مشاهده می شود با الکترولیتی استفاده نمود. همان طور که در رابطه فوق مشاهده می شود با افزایش ولتاژ لینک Dc یا مقدار مجاز ریپل یا هر دو می توان ظرفیت خازن متعادل کننده از خازن افزایش ولتاژ لینک Dc ای مقدار مجاز ریپل یا هر دو می توان ظرفیت خازن متعادل کننده توان را کاهش داد و به جای استفاده از خازن خازن الکترولیتی به دلیل مشکل محدودیت طول عمر و قابلیت اطمینان از خازن خازن فیلمی استفاده نمود.

۳- توپولوژی پیشنهادی با استفاده از جبران گر موازی

توپولوژی پیشنهادی در شکل ۲ نشان داده شدهاست. در توپولوژی پیشنهادی یک جبران گر توان بهصورت موازی برای کاهش سایز خازن ذخیره کننده انرژی پیشنهاد شدهاست. اساس کار این جبران گر بدین گونه است که توان پالسی موردنیاز سمت شبکه را تأمین کند. درنتیجه میتوان بهجای استفاده از یک خازن الکترولیتی بزرگ که وظیفه کنترل این توان پالسی برعهده دارد، از یک خازن با ظرفیت کوچکتر استفاده نمود. زمانی که توان سلول فتوولتاییک بیشتر از توان موردنیاز شبکه باشد، کلیدهای جبران گر به گونهای کلیدزنی می شود که توان در خازن جبران گر ذخیره گردد و خازن شارژ شود و زمانی که توان سلول فتوولتاییک کمتر از شبکه است کلیدزنی به گونهای است که توان خیره شده در خازن جبران گر در نیم سیکل قبل به لینکDC تزریق شده و خازن تخلیه شود.



همان طور که در شکل ۴ مشاهده می شود، با عمل کرد مناسب سیستم MPPT مقدار توان خروجی سلول فتوولتاییک مقدار ثابتی است. روابط ولتاژ و جریان و توان لحظه ای خازن مدار جبران گر به صورت زیر است:

$$v_D^{(t)} = V_D^{(dc)} + V_D^{(t)} \sin(\tau \omega t)$$
(17)

$$i_D(t) = C_D \frac{dv_D(t)}{dt} = \tau \omega C_D V_D \cos(\tau \omega t)$$
(14)

 $p_D(t) = \tau \omega C_D V_D(V_D(dc) + V_D sin(\tau \omega t)) cos(\tau \omega t)$ (۱۵) که در آن CD ظرفیت خازن مدار جبران گر و (VD(dc) مؤلفه DC ولتاژ خازن و VD مؤلفه AC ولتاژ خازن است. باتوجهبه نحوه عمل کرد مدار کمکی مقدار انرژی تزریقی به شبکه $S_{ac} < \frac{1}{\lambda}$ دوره تناوب کلیدزنی برابر با انرژی خازن مدار جبران گر SD است. با استفاده از رابطه (۴) خواهیمداشت:

$$S_{ac} = \int_{-\infty}^{\frac{Tac}{\Lambda}} (p_{pv} - p_{ac}(t))dt = \frac{V_m I_m T_{ac}}{\Lambda \pi}$$
(18)

$$S_D = \int_{\Lambda}^{\frac{Tac}{\Lambda}} p_D(t)dt = \frac{1}{\gamma} C_D V_D(\gamma V_D(dc) + V_D)$$

که در آن *W* و *I* دامنه ولتاژ شبکه و جریان تزریقی به شبکه و *T*_{ac} دو *T*_{ac} دوره تناوب زمانی شبکه است. با برابر قراردادن دو رابطه ۱۶ و ۱۷ می توان رابطهای بین اندازه خازن و مقدار ولتاژ خازن مدار جبران گر بدست آورد.

$$V_{D} = -V_{D}(dc) + \sqrt{V_{D}(dc)^{\mathsf{r}} + \frac{V_{m}I_{m}T_{ac}}{\mathfrak{r}\pi C_{D}}}$$
(1A)

ذکر این نکته ضروری است که استفاده از یک جبران گر موازی، تلفات سیستم را بهعلت شارش توان در مدار جبران گر افزایش داده و منجربه کاهش راندمان کل سیستم میشود. برای غلبه بر این مشکل باید بتوان توان این جبران گر موازی را محدود و کنترل نمود. علاوهبر این با کاهش سایز خازن لینک DC و قراردادن مدار جبران گر در سمت لینک DC، نوسانات ولتاژ لینک DC افزایش مییابد و این منجربه افزایش اعوجاج در جریان تزریقی به شبکه می گردد که باید به کمک سیستم

کنترلی مقدار این نوسانات و تأثیرات آنها را در جریان خروجی کاهش داد. در این مقاله با معرفی یک روش کنترلی ساده با بهره گیری از نظریه pq و تولید جریانهای مرجع میتوان به اهداف کنترلی فوق دستیافت. در ادامه روش کنترلی پیشنهادی معرفی شدهاست.

۳-۱- کنترل جبرانگر موازی

در سال ۱۹۸۳ پرفسور Akagi مفاهیم جدیدی از توانهای اکتیو و راکتیو لحظهای که در حالت ماندگار و گذرا برای شکل موجهای کلی ولتاژ و جریان معتبر میباشند، معرفی نمود[۲۳].

نظریه تئوری توانهای لحظهای برای سیستمهای سهفاز و تبدیل پارامترهای سیستم به دو محور متعامد معرفی شده است. برای بهره گیری از این نظریه نیاز به دو یا مقدار بیشتر پارامتر وجود دارد اما در سیستمهای تکفاز بهعلت اینکه فقط یک متغیر تکفاز وجود دارد نمی توان از این روش بهطور مستقیم برای سیستمهای تکفاز استفاده نمود و نیاز است روشی برای حل این موضوع معرفی گردد. یکی از روشها، ایجاد یک متغیر مجازی با شیفت به اندازه $\frac{T}{4}$ است. تئوری توانهای لحظهای تکفاز در مرجع [۲۹–۲۴] معرفی شده است. در این تئوری ولتاژ و جریان شبکه بهعنوان متغیر α معرفی شده و متغیر مجازی β با شیفت ۹۰ درجه روشهای مختلفی مانند تبدیل هیلبرت و SOGI نیز شیفت ۹۰ درجه روشهای مختلفی مانند تبدیل هیلبرت و SOGI نیز

ذکر این نکته ضروری است که تولید متغیر مجازی با استفاده از روشهای معرفیشده در مراجع [۲۶–۲۴، ۲۸] مستلزم شناخت کامل این روشها و تنظیم پارامترهای آنها است. باتوجهبه پیچیدگیهای طراحی این پارامترها، چنانچه این کار بهدرستی انجام نپذیرد بهخصوص زمانهایی که جریان دارای اعوجاج یا هارمونیک است، عملکرد سیستم از حالت مطلوب خود فاصله می گیرد. در روش پیشنهادی دیگر نیازی به تولید جریانهای مجازی و استفاده از این روشها نیست. در این مقاله با بهره گیری از نظریه pq اصلاحشده، سیستم تکفاز بهصورت یک سیستم سفاز نامتعادل مدل می گردد. بدینصورت که دو فاز مجازی b (17)

$$\begin{bmatrix} p \\ q_{\alpha} \\ q_{\beta} \\ q_{o} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{\alpha} & V_{\beta} & V_{o} \\ \cdot & -V_{o} & V_{\beta} \\ V_{o} & \cdot & -V_{\alpha} \\ -V_{\beta} & V_{\alpha} & \cdot \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \\ i_{o} \end{bmatrix}$$
(YT)

با جای گذاری رابطه ۱۹ و ۲۰ در رابطه ۲۱ و ۲۲ خواهیم داشت:

$$\begin{cases} i_{\alpha} = \sqrt{\frac{r}{r}}i_{a} \\ i_{\beta} = \cdot \\ 0 \end{cases}$$
 (14)

$$\begin{bmatrix} i \cdot = \frac{1}{\sqrt{r}} i_{a} \\ V_{\alpha} = \sqrt{\frac{r}{r}} (V_{a} - \frac{1}{r} V_{b} - \frac{1}{r} V_{c}) \\ V_{\beta} = \sqrt{\frac{r}{r}} (\frac{\sqrt{r}}{r} V_{b} - \frac{\sqrt{r}}{r} V_{c}) \\ V_{\rho} = \sqrt{\frac{r}{r}} (\frac{1}{\sqrt{r}} V_{a} + \frac{1}{\sqrt{r}} V_{b} + \frac{1}{\sqrt{r}} V_{c}) = .$$

$$(\Upsilon \Delta)$$

با جای گذاری روابط ۲۴ و ۲۵ در ۲۳ خواهیم داشت:

$$\begin{cases}
p = \sqrt{\frac{r}{r}} i_a \left(\frac{\sqrt{r}}{r} (V_a - \frac{1}{r} V_b - \frac{1}{r} V_c) \right) = \frac{r}{r} (V_a i_a - \frac{1}{r} i_a (V_b + V_c)) = V_a i_a \\
q_a = \frac{1}{\sqrt{r}} (i_a V_b - i_a V_c) \\
q_\beta = \frac{\sqrt{r}}{r} V_a i_a \\
q_o = -\frac{\sqrt{r}}{r} (i_a V_b - i_a V_c)
\end{cases}$$
(۲۶)

مشاهده می شود توانی که از این روش استخراج گردید، برابر با همان مقدار توان تزریقی است که در رابطه ۱ معرفی گردید. حال می توان با انتخاب مقدار نوسانی توان و، به عنوان توانی که قرار است توسط جبران گر موازی به لینک DC تزریق شود جریان های مرجع برای کنترل جبران گر را تولید کرد. توان هایی که باید جبران گردند با علامت ستاره (م^{*}₀, q^*_{a}, q^*_{a}) در رابطه (۲۷) نشان داده شده اند.

$$\begin{bmatrix} i \\ \alpha \\ * \\ i \\ \beta \\ i \\ i \\ o \end{bmatrix} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{\gamma}}} \begin{bmatrix} V_{\alpha} & V_{\alpha} & -V_{\beta} \\ V_{\beta} & -V_{\alpha} & -V_{\beta} \\ V_{\beta} & -V_{\alpha} & V_{\alpha} \\ V_{\alpha} & V_{\beta} & -V_{\alpha} & V_{\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p^{*} \\ q^{*} \end{bmatrix}$$
(YY)

شده و مقدار ولتاژ آنها همان ولتاژ فاز a (ولتاژ تکفاز) با شیفت ۱۲۰



شکل۴: شکل موجهای ولتاژ، جریان و توان خازن مدار جبران گر

$$\begin{cases} V_a = V_m \sin(\omega t) & (19) \\ V_b = V_m \sin(\omega t - 17 \cdot) \\ V_c = V_m \sin(\omega t + 17 \cdot) \\ i_a = I_m \sin(\omega t + \varphi_I) & (7 \cdot) \\ i_b = \cdot \\ i_c = \cdot \end{cases}$$

روابط نظریه pq اصلاحشده که برای سیستمهای سهفاز چهارسیمه

$$\begin{bmatrix} V_{\alpha} \\ V_{\beta} \\ V_{o} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{r}{r}} \begin{bmatrix} v & -\frac{v}{r} & -\frac{v}{r} \\ \cdot & \frac{v}{r} & -\frac{v}{r} \\ \frac{v}{r} & -\frac{v}{r} \\ \frac{v}{r} & \frac{v}{r} & \frac{v}{r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{a} \\ V_{b} \\ V_{c} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha} \\ i_{\beta} \\ i_{o} \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{r}{r}} \begin{bmatrix} v & -\frac{v}{r} & -\frac{v}{r} \\ \cdot & \frac{v}{r} & -\frac{v}{r} \\ \frac{v}{\sqrt{r}} & \frac{v}{\sqrt{r}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{a} \\ i_{b} \\ i_{c} \end{bmatrix}$$
(YY)



شکل ۵: تولید جریانهای مرجع برای کنترل جبران گر

که با استفاده از تبدیل معکوس αβ به abc مقادیر لحظهای جریانهای مرجع جبرانکننده محاسبه می شود: (۲۸)

$$\begin{bmatrix} i \\ i \\ a \\ i \\ b \\ i \\ c \end{bmatrix} = \sqrt{\frac{Y}{Y}} \begin{bmatrix} 1 & \cdot & \frac{1}{\sqrt{Y}} \\ -\frac{1}{\gamma} & \frac{\sqrt{Y}}{\gamma} & \frac{1}{\sqrt{Y}} \\ -\frac{1}{\gamma} & \frac{\sqrt{Y}}{\gamma} & \frac{1}{\sqrt{Y}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ i \\ a \\ i \\ b \\ i \\ i \\ o \end{bmatrix}$$

بهعلت این که فقط فاز a برای سیستم تکفاز موردنیاز است، بنابراین خواهیمداشت:

$$i_{a}^{*} = \sqrt{\frac{\gamma}{\tau}} (i_{\alpha}^{*} + \frac{1}{\sqrt{\tau}} i_{o}^{*})$$
^(Y9)

نحوه تولید این جریان مرجع با استفاده از روش کنترلی پیشنهادی بهصورت گرافیکی در شکل ۵ نشان داده شدهاست. همچنین از یک کنترل کننده IP برای کاهش خطای اختلاف ناشی از ولتاژ لینک DC و مقدار مرجع ولتاژ جهت تثبیت ولتاژ خازن لینک DC استفاده شدهاست. بهدلیل این که روش کنترلی پیشنهادی یک روش جدید برای کنترل جریان در سیستمهای تکفاز بدون نیاز به ایجاد جریان مجازی است. میتوان از این روش بهصورت جداگانه برای کنترل یک اینورتر تکفاز متصل به شبکه بهره گرفت. همان طورکه پیشتر گفته شد، میتوان با انتخاب توانهایی که با علامت ستاره مشخص شدهاند (که باید توسط اینورتر به شبکه منتقل شوند)، جریانهای مرجع جداگانه را برای کنترل اینورتر میتواند با

با توجه به شکل۳ فقط کافی است که توان پالسی توسط مدار جبران گر به شبکه تزریق شود درنتیجه فقط توان نوسانی اکتیو (همان توان پالسی) بهعنوان توانی که باید جبران شوند (*p) در تولید جریانهای مرجع کنترل کلیدهای جبران گر انتخاب شدهاست.

۴- طراحی فیلتر خروجی

برای اتصال اینورترهای منبع ولتاژی به شبکه از یک فیلتر به جهت کاهش هارمونیکهای جریان ناشی از کلیدزنی استفاده می شود. ساده ترین و معمول ترین فیلتر، استفاده از یک سلف سری است. اما مقدار این سلف باتوجه به الزامات اتصال اینورترها و درصدد هارمونیکهای مجاز فیلتر LCL پیشنهاد می شود [۳۱–۳۰]. فیلتر LCL معمولاً دارای فیلتر LCL پیشنهاد می شود [۳۱–۳۰]. فیلتر LCL معمولاً دارای قابل توجه ای کاهش می دهد. علاوه براین در مواردی که هارمونیک فرکانس کلیدزنی در سیستم وجود داشته با شد با مقدار راکتانس کمتری، می توان این هارمونیکها را کاهش داد. ساختار کلی این فیلتر به همراه مقاومت میراکننده به صورت زیر است:



که در آن L_1 سلف سمت اینورتر و L_7 سلف سمت شبکه و C_f و R_f خازن و مقاومت میراکننده است. توان راکتیو موردنیاز ممکن است منجربه رزونانس متقابل خازن موازی با شبکه گردد. درنتیجه وجود مقاومت میراکننده بهصورت سری با خازن ضروری است. برای طراحی LCL سیستم تکفاز از تعمیم الگوریتم ارائهشده در مرجع [۳۱] که برای سیستم سهفاز معرفی شدهاست، استفاده گردیدهاست. مقادیر امپدانس مبنا و خازن مبنا بهصورت زیر محاسبه می شود:

$$Z_b = \frac{E_n^{\gamma}}{P_n} \tag{(Y \cdot)}$$

$$C_b = \frac{1}{\omega_s Z_b} \tag{(1)}$$

که در آن En ولتاژ نامی، Pn توان اکتیو نامی و © فرکانس زاویهای شبکه است. قبل از طراحی فیلتر، تعدادی محدودیت در مقادیر پارامترهای طراحی وجود دارد:

- ۱) مقدار کل اندوکتانس (L₁+L_r) نباید بیشتر از ده درصد امپدانس مبنا باشد وگرنه باعث افت ولتاژ قابل توجهی خواهدشد که درنتیجه نیازمند به ولتاژ لینک DC بزرگتر و افزایش تلفات کلیدزنی می گردد.
- ۲) مقدار خازن C_f با درنظرگرفتن بیشینه تغییرات ضریب توان دیده شده از دید شبکه تعیین می گردد که معمولاً مقدار آن
 ۵٪ خازن مبنا انتخاب می گردد. البته چنان چه بخواهیم مقدار راکتانس سلفی فیلتر بیشتر جبران گردد، می توان مقادیر بیشتری را انتخاب نمود که طبیعتاً هزینه های سیستم و مقدار ریپل جریان افزایش می یابد.
- ۳) فرکانس تشدید یا رزونانس باید در محدوده زیر قرار بگیرد تا از مشکلات رزونانسی جلوگیری گردد.

$$+ \omega_g < \omega_{res} = \sqrt{\frac{L_1 + L_{\gamma}}{L_1 L_{\gamma} C_f}} < \frac{\omega_{sw}}{\tau}$$
(TY)

که در آن @res فرکانس زاویهای تشدید و ‱ فرکانس زاویهای کلیدزنی است. گامهای طراحی فیلتر بهصورت زیر است:



برای اینورتر تمام پل تکفاز نحوه تغییرات ولتاژ خروجی و تغییرات جریان دو سر سلف در شکل زیر نشان داده شدهاست:



شکل ۸: ولتاژ خروجی و تغییرات جریان دو سر سلف

زمانی که فرکانس سوئچینگ fsw خیلی بزرگتر از فرکانس اصلی (۵۰ هرتز) باشد میتوان گفت مقدار متوسط زمانی ولتاژ خروجی اینورتر ۷av در یک دوره تناوب کلیدزنی مقدار ثابتی است. بنابراین جریان خروجی فیلتر یا همان جریان سلف خروجی در طی هر دوره تناوب کلید زنی شکلی مشابه، شکل ۸ خواهدداشت.

مقدار پیک تا پیک جریان سلف خروجی (۵iL) بهصورت زیر به دست خواهدآمد:

(۳۳)

$$\begin{cases} V_L = L_{\gamma} \frac{di}{dt} \rightarrow \Delta i_L = \frac{V}{L_{\gamma}} V_L \Delta t \\ \Delta i_L = \tau \Delta i_{L \max} = \frac{(V_{dc} - V_{AV})}{L} D_{\gamma} T_s \end{cases}$$

 V_{dc} که در آن Δi_{Lmax} پیک جریان سلف خروجی، V_L ولتاژ دو سر سلف، Δi_{Lmax} ولتاژ منبع S_1 دوره تناوب کلیدزنی و D_1 زمان روشنبودن کلید S_1 ولتاژ منبع D_2 ، D_2 است. با توجهبه شکل ۸ روابط زیر را می توان به دست آورد.

$$V_{AV}(\omega t) = \frac{1}{T_s} \left(\int_{-1}^{D_s} V_{dc} dt + \int_{D_s}^{T_s} -V_{dc} dt \right)$$

$$= V_{dc} (\Upsilon D_s - 1)$$

$$e_a = m_a V_{dc} \sin(\omega t)$$
(\mathcal{T}\Delta)
(\mathcal{T}\Delta)

که در آن m_a ضریب مدولاسیون است. با برابر قراردادن رابطه ۳۴ و ۳۵ مقدار D₁ بهدست خواهدآمد:

$$D_{1} = \frac{1 + m_{a} \sin(\omega t)}{r}$$
(3.7)

با جای گذاری رابطه ۳۶ در رابطه ۳۳ مقدار بیشینه تغییرات جریان دو سر سلف محاسبه می شود.



شکل ۹: ساختار سیستم کنترلی اینورتر

$$\Delta i_{L \max} = \frac{\Delta i_{L}}{r} = \frac{V_{a} C_{s}}{r} (r - m_{a}^{r} \sin^{r}(\omega t))$$
(°Y)

که مقدار بیشینه تغییرات جریان سلف برابر است با:

$$\Delta i_{L \max} = \frac{V_{dC}T_s}{\frac{F_L}{F_L}}$$
(۳۸)

بنابراین با انتخاب
$$I_{pp}$$
 مقدار پیک $\Delta i_{Lmax} = (1.\% - 7.\%)I_{pp}$ مقدار پیک تا پیک جریان خروجی است، مقدار سلف سمت اینورتر بهدست میآید.
 $L_{\gamma} = \frac{V_{dc}T_s}{\epsilon_{\Delta i}L_{max}}$

گام دوم: محاسبه خازن شاخه موازی

همانطورکه قبلاً گفته شد مقدار خازن را ۵ درصد مقدار خازن مبنا انتخاب میشود.

$$C_f = \cdots \Delta C_b \tag{(f.)}$$

گام سوم: محاسبه سلف سمت شبکه

با تعریف ضریب تضعیف (Ka) که نشاندهنده نسبت بین جریان هارمونیکی تولیدشده توسط اینورتر و جریان تزریقی به شبکه است می توان رابطهای برای محاسبه L2 به دست آورد [۳۱].

$$\frac{i_g(h)}{i_s(h)} = k_a \tag{(f1)}$$

$$L_{\Upsilon} = \frac{\sqrt{\frac{1}{k_a}}}{C_f w_{SW}^{\Upsilon}}$$
(*Y)

که در آن Ka ضریب تضعیف، Cf خازن شاخه موازی است. برای داشتن کمترین رزونانس (بیشترین ضریب میرایی) میتوان مقدار L2 را با L برابر انتخاب کرد اما در مرجع [۳۱] نشان داده شدهاست که میتوان بدون اینکه اشکالی در سیستم به وجود آید با انتخاب ضریب تضعیف کمتر (بهعنوان مثال ۲۰٪) مقادیر کوچکتری برای L2 انتخاب شود. ذکر

این نکته ضروری است که هر چه سایز فیلتر سمت شبکه افزایش یابد بهتبع آن هزینه بیشتری به سیستم تحمیل خواهدشد. **گام چهارم:** بررسی شرطهای پیش طراحی

چنانچه شرطهای پیش طراحی که شامل محدوده فرکانس تشدید و امپدانس کل فیلتر رعایت نشدهاست دوباره به گام سوم برگشته و مقدار ضریب تضعیف را تغییر میدهیم.

گام پنجم: محاسبه مقاومت میراکننده

برای بهبود میرایی رزونانس، اندازه این مقاومت ¹ مپدانس خازن سری ۳ قرار داده میشود. چنانچه مقدار این مقاومت بزرگ انتخاب شود تلفات سیستم افزایشیافته و بازده کل کاهش مییابد.

$$R_f = \frac{1}{\tau_{w_{res}} C_f} \tag{FT}$$

۵- نتایج تحلیلی و شبیهسازی

شکل ۹ ساختار سیستم کنترلی اینورتر متصل به شبکه بههمراه جبران گر موازی را نشان می دهد که در آن با اندازه گیری ولتاژ و جریان سلول خورشیدی و بهره گیری از روش آشفتن و مشاهده^۲، سیگنال کنترلی مبدل DC/DC تولید می گردد. صحت روش پیشنهادی کنترلی براساس نرمافزار Matlab/Simulink بررسی گردیدهاست. برای شبیه سازی سلول خورشیدی از اطلاعات سیستم فتوولتاییک ۳ کیلووات نصب شده در دانشگاه بیر جند استفاده شده است که مشخصه ولتاژ – جریان و ولتاژ – توان آن در دماهای مختلف در شکل ۱۰ نشان داده شده است. همچنین پارامترهای موردنیاز برای مدل کردن سلول خورشیدی در محیط شبیه سازی در جدول ۱ قابل مشاهده است. پارامترهای کلی سیستم تست نیز در جدول ۲ آورده شده است.



شکل ۱۰– سلول خورشیدی الف). مشخصه ولتاژ –جریان در دماهای مختلف ب). مشخصه ولتاژ –توان در دماهای مختلف







شکل ۱۱: الف). ولتاژ شبکه مدلشده ب). طیف هارمونیکی شبکه مدلشده

بهعلت این که مقدار ولتاژ پنل خورشیدی در بیشینه توان بیشتر از سطح ولتاژ سیستم تکفاز است، از یک مبدل کاهنده برای کاهش ولتاژ لینک DC جهت اتصال اینورتر به شبکه تکفاز استفاده شدهاست.

جدول ۱: مشخصات سلول خورشیدی

نماد	پارامتر	مقدار
I _{Sc}	جريان اتصال كوتاه	λ/۲۱ A
KI	ضريب دمايي جريان اتصال كوتاه	•/••٣٢
V _{oc}	ولتاژ مدار باز	377/9 V
Kv	ضريب دمايي ولتاژ مدار باز	-•/17٣
Ns	تعداد سلول سری	۵۴
N _{ss}	تعداد ماژول سری	۱۵
N _P	تعداد سلول موازى	١
N _{PP}	تعداد ماژول موازی	١
Rs	مقاومت سرى	\cdot /ty Ω
R _t	مقاومت موازى	9.1/TT91 Ω
V _{mp}	ولتاژ در بیشینه توان	tr/t
Imp	جریان در بیشینه توان	۲/۶۱ A
Р	بيشينه توان	۳ kW

جدول ۲: پارامترهای سیستم تست

نماد	پارامتر	مقدار
fg	فركانس شبكه	۵۰ Hz
fsw	فركانس كليدزني	۱۰ KHz
Vgrid	ولتاژ مؤثر شبكه	770 V
L1	سلف سمت اينورتر	۲mH
L2	سلف سمت شبکه	۰/۱۵mH
Cf	خازن فيلتر	۱۰μF
Rf	مقاومت ميراكننده	۱/۲۵ Ω
Cdc	خازن لینک DC	۲۰۰µF
L	سلف مبدل کاهنده	۳/۳ mH
Cpv	خازن ورودی پنل	۱۰۰ μF
Ccomp	خازن جبرانگر	ι·· μF
Lcomp	سلف جبران گر	۱/۳ mH
Кр	بهره تناسبی کنترل کننده ولتاژ لینک DC	•/• 1
Ki	بهره انتگرالگیر کنترلکننده ولتاژ لینک DC	۴/۱

شکل ۱۱ (الف) ولتاژ شبکه مدل شده را نشان میدهد. به جهت افزایش دقت شبیه سازی، برای مدل کردن شبکه از یک منبع ولتاژ سینوسی هارمونیکی استفاده شده است. طیف هارمونیکی ولتاژ مدل شده شبکه در شکل ۱۱ (ب) نشان داده شده است.

در قسمت (الف) شکل ۱۱ نشان داده شدهاست که با به کارگیری سیستم کنترلی پیشنهادی مقدار ولتاژ لینک DC با مقداری ریپل برروی مقدار مرجع خود (۲√۲۲۰) تثبیت شدهاست. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه مقدار این نوسانات تا حدودی بزرگ است اما ساختار و روش كنترلى پيشنهادى توانسته است علاوهبر كاهش سايز خازن لينك DC، مانع از تأثیر این مقدار نوسانات بر جریان خروجی شود و THD جریان را در حد مطلوبی نگه داشتهاست. در ادامه شکل ۱۱ مقدار ریپل (نوسان) ولتاژ لینک DC برای سه وضعیت استفاده از ساختار پیشنهادی با خازن لینکDC ۲۰۰ میکروفاراد، بدون مدار متعادل کننده کمکی با خازن لینکT۰۰ DC میکرو فاراد و بدون مدار متعادل کننده کمکی با خازن لینکDC ۱۰۰۰ میکرو فاراد را نشان میدهد. طبق رابطه ۱۲ بدون مدار کمکی متعادل کننده توان با چنین مقدار Δ۷، مقدار خازن لینک DC برابر با مقدار یک میلیفاراد می شود که با بهره گیری از مدار متعادل کننده توان، با درنظر گرفتن خازن مدار جبران گر، مقدار خازن تقريباً به ۳ برابر كاهش يافتهاست. بدون مدار متعادل كننده توان كمكي و با ظرفیت بهدست آمده یک میلی فاراد تنها ملزم به استفاده از خازن الكتروليتي خواهيم بود (ساختار متداول). كاهش ظرفيت خازن لينك DC در جهت استفاده از خازنهای فیلمی با طول عمر بالاتر بدون استفاده از مدار متعادل کننده کمکی طبق رابطه ۱۲ منجربه افزایش نوسانات ولتاژ لینک DC و هارمونیک جریان تزریقی به شبکه می شود و بر عمل کرد سیستم MPPT در ردیابی نقطه بیشینه توان تأثیر نامطلوبی خواهدداشت.



شکل ۱۲: (a) ولتاژ لینک DC با استفاده از جبران گر موازی با خازن ۲۰۰ میکروفارادی (b) ریپل ولتاژ لینک DC با استفاده از جبران گر موازی با خازن ۲۰۰ میکروفارادی (c) ریپل ولتاژ لینک DC بدون استفاده از مدار متعادل کننده توان کمکی (ساختار متداول) با خازن ۲۰۰ میکروفارادی (b) ریپل ولتاژ لینک DC بدون استفاده از مدار متعادل کننده توان کمکی (ساختار متداول) با خازن ۱۰۰۰ میکروفارادی

در شکل ۱۳ جریان تزریقی به شبکه برای سه وضعیت استفاده از ساختار پیشنهادی با خازن لینک ۲۰۰DC میکروفاراد، بدون مدار متعادل کننده کمکی با خازن لینک ۲۰۰DC میکروفاراد و بدون مدار متعادل کننده کمکی با خازن لینک ۱۰۰۰DC میکروفاراد را نشان می دهد. همان طور که در این شکل مشاهده میشود در ساختار متداول (بدون مدار متعادل کننده توان کمکی) با خازن ۲۰۰ میکروفارادی جریان خروجی هارمونیک قابل توجهی دارد. همچنین در وضعیت ساختار متداول (بدون مدار متعادل کننده توان کمکی) با خازن ۲۰۰ میکروفارادی بااینکه در شکل ۱۲ نشان داده شد که دارای نوساناتی برابر با وضعیت استفاده از ساختار پیشنهادی است اما جریان تزریقی تا حدودی از حالت سینوسی خارجشده و همراه با هارمونیک نسبتاً بالایی است.



 (a) با استفاده از جبران گر موازی با خازن ۲۰۰ میکروفارادی (b) بدون استفاده از مدار متعادل کننده توان کمکی (ساختار متداول) با خازن ۲۰۰ میکروفارادی (c) بدون استفاده از مدار متعادل کننده توان کمکی (ساختار متداول) با خازن ۱۰۰۰ میکروفارادی)

برای کاهش این نوسانات جریان خروجی بدون کمکی مدار متعادلکننده توان، میتوان با انتخاب خازن بزرگتر برای لینک DC (الزاماً از نوع الکترولیتی) مقدار این نوسانات را به حد مطلوب جهت عصال به شبکه کاهش داد که تأثیر این افزایش خازن لینک DC در طیف هارمونیکی جریان خروجی در شکل ۱۴ نشان داده شدهاست. در شکل ۱۴ مشاهده میکنید با انتخاب ساختار متداول برای متعادلسازی و مقدار آن به ۲/۱۲٪ میرسد. با انتخاب خازن الکترولیتی به مقدار ۲ط برابر خازن یک میلیفاراد، مقدار THD جریان تقریباً با مقدار سازی ساختار پیشنهادی یکسان میشود و میتوان مقایسه بهتری بین دو ساختار براساس THDهای یکسان انجام داد.



شکل ۱۴: طیف هارمونیکی جریان تزریقی به شبکه الف). خازن ۱ میلیفاراد (الکترولیتی)-ساختار متداول ب). خازن ۴ میلیفاراد (الکترولیتی)-ساختار متداول ج). خازن ۲۲۰ میکروفاراد (فیلمی) – جبران گر موازی

همان طور که در شکل ۱۴ مشاهده می شود مقدار THD جریان تزریقی به شبکه با استفاده از ساختار پیشنهادی مقداری کمتر از ۵٪ است. این مقدار هارمونیک الزامات و استانداردهای موجود جهت اتصال به شبکه را برآورده می سازد. ذکر این نکته ضروری است که در حالت بدون مدار متعادل کننده توان (ساختار متداول)، THD جریان مقدار بزرگی است. برای کاهش THD در این حالت حداقل مقدار خازن لینک DD باید ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد که می توان گفت با درنظر گرفتن THD یکسان برای دو حالت بدون مدار کمکی و مدار کمکی، ساختار و روش لینک DC را کاهش دهد بدون این که عمل کرد سیستم دچار ایراد گردد. این یک DC را کاهش دهد بدون این که عمل کرد سیستم دچار ایراد گردد. با سایز به دست آمده برای خازن لینک DC، می توان استفاده از خازن های با سایز به دست آمده برای خازن لینک DC، می توان استفاده از خازن های با سایز به دست آمده برای خازن لینک OC، می توان استفاده از خازن های با سایز به دست آمده برای خازن لینک DC، می توان استفاده از خاز مای با سایز به دست آمده برای خازن لینک OC، می توان استفاده از خاز مای مر الکترولیتی به دلیل مشکلاتی همچون طول عمر، در سیستمهای فتوولتاییک محدود نمود و خازن های فیلمی با ظرفیت پایین و طول عمر

در شکل ۱۵ مقدار توان لحظهای تزریقی به شبکه، مقدار توان متوسط و توان پالسی نشان داده شدهاست. همان طور که در قسمت (ب) شکل ۱۵ مشاهده می شود، مقدار توان متوسط خروجی مشابه آن چه در رابطه ۴ بیان گردید تقریباً برابر توان تولیدی سلول خور شیدی است.



شکل ۱۵: (a) توان لحظهای تزریقی به شبکه (b) توان متوسط (c) توان پالسی





شکل ۱۶ بهترتیب ولتاژ، جریان و توان سلول خورشیدی را نشان میدهد. همانطورکه در این شکلها مشاهده میکنید ساختار پیشنهادی عمل کرد نامطلوبی برروی سیستم ردیابی بیشینه توان نداشته و مشخصات خروجی سلولهای با مقداری ریپل جزئی روی شرایط حصول بیشترین توان تثبیت شدهاند.

۶- هزینه ساختار پیشنهادی

قبل از مقایسه هزینهای بین ساختار پیشنهادی (جبران گر موازی) و ساختار متداول (استفاده از خازنهای الکترولیتی بزرگ)، ذکر چند نکته ضروری است:

- ۱) همان طور که در شکل ۹ نشان داده شد، عمده تجهیزات جبران گر موازی پیشنهادی شامل: ۴ کلید برای مبدل پل، دو سلف فیلتر خروجی جبران گر و دو خازن فیلمی Ccomp و Cdc است.
- ۲۰۰ Cdc میکروفاراد است و باتوجهبه
 ۱ین که در این رنج ظرفیت، تنوع سازندگان خازن فیلمی کم
 است از دو خازن ۱۰۰ میکروفارادی موازی استفاده شدهاست.
- Digi- قیمتها براساس قیمتهای موجود در سایت (۳ key(Electronic Components Distributor)
- ۴) برای مقایسه طول عمر خازنها دمای ۸۵ سانتی گراد در نظر گرفته شدهاست.
- ۵) به علت تفاوت قیمتی که میان سازندگان قطعات به خصوص در مورد خازنها وجود دارد، قیمتهای یک سازنده برای هر دو نوع خازن الکترولیتی و فیلمی در نظر گرفته شده است. در این مقاله مقایسه هزینهها براساس قیمتهای سازنده KEMET - Electronic Components
- ۶) همان طور که در شکل ۱۴ نشان داده شدهاست با استفاده از خازن الکترولیتی مقدار THD جریان خروجی از حد استاندارد
 و الزامات اتصال به شبکه بیش تر است. برای کاهش THD جریان، مقدار خازن لینک DC بزرگ تر انتخاب شدهاست (۴)

برابر) تا THD جریان تزریقی به شبکه در دو ساختار یکسان گردد تا مقایسه بهتری بین دو ساختار انجام شود.

۲) در قسمت مقایسه هزینهها، تنها هزینههای ناشی از قراردادن خازن الکترولیتی بزرگ در لینک DC و هزینه اضافهشده به سیستم ناشی از جبران گر موازی پیشنهادی به سیستم شامل اضافهشدن ۴ کلید و دریوارهای آن و خازنهای فیلمی pccomp و DC و سلفهای فیلتر جبران گر و ... لحاظ شدهاست. هزینههای مشترک در دو ساختار شامل اینورتر و مبدل DC و ... در نظر گرفته نشدهاست. در قسمت طول عمر، فقط طول عمر مربوط به خازنها باتوجهبه دما کاری و اطلاعات موجود در دیتا شیت ها در جدول جای گذاری شدهاست.

جدول ٣- مقايسه هزينهها					
طول عمر (ساعت) در دمای ۸۵ 🧴 روش		هزينه			
	درجه سانتیگراد	(\$)			
وضعیت ۱- خازن الکترولیتی	۲٬۰۰۰	82/18			
وضعیت ۲- خازن الکترولیتی	۵.۰۰۰	11./.4			
وضعیت ۳- خازن الکترولیتی	١٢	180/22			
روش پیشنهادی) • • • • • •	117/77			

همان طور که در جدول فوق مشاهده می کنید بدون درنظر گرفتن طول عمر و قابلیت اطمینان، استفاده از خازنهای الکترولیتی بزرگ، هزینه پایین تری نسبت به ساختار پیشنهادی دارد. چنان چه از خازنهای الکترولیتی با طول عمر بیش تر استفاده شود، هزینهها افزایش پیدا می کند. هزینه جبران گر موازی پیشنهادی تقریباً مشابه با هزینههای وضعیت ۲ است با این تفاوت که ساختار پیشنهادی طول عمر و قابلیت اطمینان به مراتب بالاتری نسبت به وضعیت ۲ دارد و با به کار گیری روش پیشنهادی طول عمر تقریباً به اندازه ۲۰ برابر افزایش یافته است. چنان چه از خازنهای الکترولیتی با طول عمر بالا (وضعیت ۳) استفاده شود، هزینه روش جبران گر موازی بسیار کمتر از ساختار متداول خواهدشد در حالی که طول عمر سیستم در روش پیشنهادی به اندازه ۸ برابر بیشتر شده است. برای رسیدن به یک مقایسه هزینه ای به تر از لحاظ مدت زمانی کار کرد جدول ۴ یک مقایسه هزینه ای برای کار کرد ۱۰ سال به ازای روزی

در این وضعیت بهترین حالت ممکن برای استفاده از خازن الکترولیتی از جدول ۳ انتخاب شدهاست. همانطورکه در جدول ۴ مشاهده می شود با استفاده از خازنهای الکترولیتی با طول عمر ۱۲ هزار ساعت در یک پروسه ۱۰ سال نیاز به تعویض خازن برای ۳ بار است این در حالی است که طول عمر خازن استفاده شده در روش پیشنهادی بسیار بیشتر بوده و اصلاً نیازی به تعویض برای این مدت ندارد. هزینه تعویض مربوط به خازن بدون درنظر گرفتن نرخ تورم سالیانه است. با

مقایسه هزینهای که در این دو وضعیت میتوان نتیجه گرفت که ساختار پیشنهادی از لحاظ اقتصادی نیز مقرون بهصرفه است.

جدول ۲-مقایسه هرینهای برای کارکرد ۱۰ ساله					
	طول عمر خازن (ساعت) در دمای ۸۵ درجه سانتیگراد	طول عمر به روز (کارکرد روزانه: ۱۰ ساعت)	هزینه در بازه زمانی ۱۰ ساله ((\$		
وضعیت ۳- خازن الکترولیتی	17	۱،۲۰۰ روز (۳/۳ سال)	T X 1T•/5 =T91/5		
روش پیشنهادی	1	۱۰،۰۰۰ روز (۲۷/۴ سال)	180/2		

جدول ۴- مقایسه هزینهای برای کارکرد ۱۰ ساله

۷- نتیجهگیری

در این مقاله ساختار و روشی در جهت کاهش ظرفیت خازن متعادل کننده و سپس جبران اثرات منفی ازجمله افزایش شدید ریپل ولتاژ در لینک DC و افزایش اعوجاج جریان خروجی، ارائه شدهاست. با استفاده از ساختار و روش پیشنهادی ظرفیت خازن متعادل کننده توان تقریباً به ۱۳ برابر کاهش یافتهاست و این کاهش ظرفیت به گونهای است که می توان به جای استفاده از خازن های الکترولیتی با طول عمر متوسط ۵ سال از انواع دیگر خازنها با طول عمر بالاتر و ابعاد و ظرفیت کوچکتر مانند خازنهای فیلمی استفاده نمود. روش کنترلی پیشنهادی با بهره گیری از تئوری توان لحظه ای عمل کرد مناسبی را در کاهش اثرات نوسانات ولتاژ لینک DC برروی جریان خروجی نشان میدهد. همچنین نشان داده شد که هزینههای اضافهشده به سیستم ناشی از جبرانگر موازی در مقایسه با خازنهای الکترولیتی با طول عمر متوسط ۵۰۰۰ ساعت، تقریباً برابر است. برای کنترل جریان جبران گر از روش pq اصلاحشده و مدلسازی سیستم تکفاز بهصورت یک سیستم سهفاز نامتعادل که دو جریان فاز آن صفر است، استفاده شدهاست. نتایج شبیهسازی نشاندهنده صحت عمل کرد توپولوژی و ساختار کنترلی پیشنهادی است.

مراجع

- M.Schmela, EPI Association, "Global market outlook for solar power 2016-2020", 2016.
- [۲] سعید عباسی، علی اصغر قدیمی و امیر حسین ابوالمعصومی، "حذف نوسانات توان اکتیو تزریقی سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه در شرایط افت ولتاژ،" مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد ۴۶، شماره ۲، صفحه ۱۵۸ – ۱۴۹۹، تابستان ۱۳۹۵.
- [3] M. Monfared and S. Golestan, "Control strategies for single-phase grid integration of small-scale renewable energy sources: A review," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 16, pp. 4982-4993, 9// 2012.
- [4] Q. Li and P. Wolfs, "A Review of the Single Phase Photovoltaic Module Integrated Converter Topologies With Three Different

- [19] M. H. Zare, M. Mohamadian, and R. Beiranvand, "Single-stage AC module with series power decoupling capability for connecting PV to a single-phase power grid," IET Power Electronics, vol. 10, pp. 517-524, 2017.
- [20] M. H. Zare, M. Mohamadian, and R. Beiranvand, "A Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverter Based on a Three-Switch Three-Port Flyback With Series Power Decoupling Circuit," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, pp. 2062-2071, 2017.
- [21] X. Zong, "A Single Phase Grid Connected DC/AC Inverter with Reactive Power Control for Residential PV Application," Master of Science, Graduate Department of Electrical and Computer Engineering, University of Toronto, 2011.
- [22] P. T. Krein, R. S. Balog, and M. Mirjafari, "Minimum Energy and Capacitance Requirements for Single-Phase Inverters and Rectifiers Using a Ripple Port," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, pp. 4690-4698, 2012.
- [23] E. H. W. Hirofumi Akagi, Mauricio Aredes, Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning: Wiley-IEEE Press, 2007.
- [24] M. Saitou and T. Shimizu, "Generalized theory of instantaneous active and reactive powers in single-phase circuits based on Hilbert transform," IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, Australia, 2002.
- [25] M. Saitou, N. Matsui, and T. Shimizu, "A control strategy of single-phase active filter using a novel d-q transformation," 38th IAS Annual Meeting on Conference Record of the Industry Applications Conference, USA, 2003.
- [26] T. R. Ciobotaru M, Blaabjerg F., "A New Single-Phase PLL Structure Based on Second Order Generalized Integrator," 37th IEEE Power Electronics Specialists Conference, Jeju, South Korea, 2006.
- [27] S. Peng, A. Luo, Z. Lv, J. Wu, and L. Yu, "Power control for single-phase microgrid based on the PQ theory," 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Beijing, China, 2011.
- [28] S. Golestan, M. Monfared, and J. M. Guerrero, "Second order generalized integrator based reference current generation method for single-phase shunt active power filters under adverse grid conditions," 4th Annual International Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference, Tehran, Iran, 2013.
- [29] A. H. Ukande, S. L. Tiwari, S. G. Kadwane, and A. Kadu, "Generalise PQ theory with SPWM for single phase shunt active filter applications," 2015 IEEE Power, Communication and Information Technology Conference (PCITC), Bhubaneswar, India, 2015.

[۳۰] حسین صفامهر؛ تورج عباسیان نجف آبادی؛ فرزاد رجایی

[31] A. Reznik, M. G. Sim, x00F, es, A. Al-Durra, and S. M. Muyeen, "Filter Design and Performance Analysis for Grid-Interconnected Systems," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 50, pp. 1225-1232, 2014. DC Link Configurations," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 23, pp. 1320-1333, 2008.

- [5] S. Harb and R. S. Balog, "Reliability of Candidate Photovoltaic Module-Integrated-Inverter (PV-MII) Topologies—A Usage Model Approach," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, pp. 3019-3027, 2013.
- [6] S. B. Kjaer, J. K. Pedersen, and F. Blaabjerg, "A review of singlephase grid-connected inverters for photovoltaic modules," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41, pp. 1292-1306, 2005.
- [7] A. C. Kyritsis, N. P. Papanikolaou, and E. C. Tatakis, "A novel Parallel Active Filter for Current Pulsation Smoothing on single stage grid-connected AC-PV modules," 2007 European Conference on Power Electronics and Applications, Aalborg, Denmark, 2007.
- [8] T. Shimizu, K. Wada, and N. Nakamura, "Flyback-Type Single-Phase Utility Interactive Inverter With Power Pulsation Decoupling on the DC Input for an AC Photovoltaic Module System," Power Electronics, IEEE Transactions on, vol. 21, pp. 1264-1272, 2006.
- [9] S. B. Kjaer, J. K. Pedersen, and F. Blaabjerg, "A review of singlephase grid-connected inverters for photovoltaic modules," Industry Applications, IEEE Transactions on, vol. 41, pp. 1292-1306, 2005
- [10] H. Hu, S. Harb, N. Kutkut, I. Batarseh, and Z. J. Shen, "A Review of Power Decoupling Techniques for Microinverters With Three Different Decoupling Capacitor Locations in PV Systems," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, pp. 2711-2726, 2013.
- [11] J. Schonberger, "A single phase multi-string PV inverter with minimal bus capacitance," 13th European Conference on Power Electronics and Applications, Barcelona, Spain, 2009.
- [12] F. Shinjo, K. Wada, and T. Shimizu, "A Single-Phase Grid-Connected Inverter with a Power Decoupling Function," 2007 IEEE Power Electronics Specialists Conference, Orlando, USA, 2007.
- [13] G. H. Tan, J. Z. Wang, and Y. C. Ji, "Soft-switching flyback inverter with enhanced power decoupling for photovoltaic applications," Electric Power Applications, IET, vol. 1, pp. 264-274, 2007.
- [14] Q. Li, Wolfs, Peter J., Senini, Steven.. Clayton, Vic., "A hard switched high frequency link converter with constant power output for photovoltaic applications," presented at the Australasian Committee for Power Engineering (ACPE), 2002.
- [15] C. R. Bush and W. Bingsen, "A single-phase current source solar inverter with reduced-size DC link," 2009 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, San Jose, USA, 2009.
- [16] P. N. Enjeti and W. Shireen, "A new technique to reject DC-link voltage ripple for inverters operating on programmed PWM waveforms," Power Electronics, IEEE Transactions on, vol. 7, pp. 171-180, 1992.
- [17] H. Wang, H. S. H. Chung, and W. Liu, "Use of a Series Voltage Compensator for Reduction of the DC-Link Capacitance in a Capacitor-Supported System," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, pp. 1163-1175, 2014.
- [18] B. J. Pierquet and D. J. Perreault, "A Single-Phase Photovoltaic Inverter Topology with a Series-Connected Energy Buffer," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 28, pp. 4603-4611, 2013.

زيرنويسها

- ¹ Maximum Power Point Tracking
- ² Perturb & Observe(P&O)